

# ÍNDICE

- Acopladores ópticos, 571-575  
 Acoplamiento capacitivo, 270, 300  
 Aislador, 36  
**Alfa, 178**  
**Amplificación, 190**  
 Amplificador, 190  
     acoplado por transformador, 303  
     clase A, 422-439  
     clase B, 439-448  
     clase C, 449-456  
     de acoplamiento directo, 302, 497  
     de audio, 306, 523, 679  
     de FI (frecuencia intermedia), 306  
     de instrumentación, 722-725  
     de potencia, 306, 422-462  
     de promedio, 710  
     de RF (radiofrecuencia), 306, 407  
     diferencial, 391-399, 596-605  
     en base común, 295-298  
     en colector común, 291-295  
     en compuerta común, 401-403  
     en drenaje común, 399-401  
     en emisor común, 278-290  
     en fuente común, 391-399  
     en señal grande, 425  
     en señal pequeña, 270-272  
     multietapa, 299-303  
     push-pull (equilibrado), 439-448  
     sumador, 708-715  
 Amplificador complementario, 439  
 Amplificador diferencial, 596-605  
 Amplificador equilibrado (push-pull), 439-448  
 Amplificador multietapa, 299  
 Amplificador operacional (amp. op.), 594-635  
 Amplitud modulada (AM), 269, 306  
 Ancho de banda, 503, 655, 662  
 Ancho de banda para ganancia unitaria, 655, 664  
 Anillo de fase cerrada, 787-791  
 Ánodo, 59  
 Antena, 306, 407  
 Atenuación, 284, 479  
 Atómico  
     enlace, 31  
     número, 29  
     peso, 29  
 Aumento (aumento de ganancia) semilogarítmico de acuerdo con el efecto del efecto de la ganancia de la señal de salida en la ganancia de la señal de salida.

- Avance (avance de campo magnético en el voltaje de salida para un cambio de campo magnético en el voltaje de salida).  
 Banda de conducción, 33, 151  
 Banda de valencia, 30  
 Base, 276  
**Beta, 178, 184, 186, 277**  
**BIFET, 627**  
**Caida (en dB), 486, 812**  
**Canal, 348, 349, 351**  
 Capacitancia  
     de entrada, 336, 477  
     de la capa de empobrecimiento, 46, 141  
     de Miller, 477  
     de salida, 477  
     de transferencia inversa, 475  
     del transistor, 473, 513  
 Capacitancia de la capa de empobrecimiento, 46, 141  
 Capacitancia del transistor, 475, 513  
 Capítulo  
     de acoplamiento, 474  
     de compensación, 672, 677  
     de puente, 284, 490  
 Capacitor de puente, 284, 490  
 Característica de transferencia, 331, 353  
 Carga, 135, 285, 300, 394, 438  
 Cascada, 817, 820  
 Cátodo, 59  
 Circuito de barreta, 551  
 Circuito equivalente, 129, 272, 279, 387, 392, 544, 560  
 Circuito sintonizado, 143  
 Circuito tanque, 143  
**Clase A, 422-439**  
**Clase B, 439-448**  
**Clase C, 449-456**  
 Coeficiente de temperatura, 131  
 Colector, 174, 182  
 Comparador, 694, 707  
 Comparador con limitación de la salida, 700

Comparador de ventana, 703  
 Compensación, 626, 671-679  
 Compensación por prealimentación, 678  
 Compuerta, 324  
 Compuerta aislada, 348  
 Conducción, 33  
 Conductor, 36  
 Comutación forzada, 547  
 Control de fase, 549, 558  
 Control de potencia de media onda, 550  
 Convertidor analógico a digital, 706, 732  
 Convertidor de corriente a voltaje, 726  
 Convertidor de voltaje a corriente, 726  
 Convertidor digital a analógico, 712  
 Corte, 184, 192, 329, 439  
 Corriente, 35, 43, 46, 177  
 Corriente de compensación de entrada, 608  
 Corriente de fuga, 204  
 Corriente de fuga inversa, 204  
 Corriente de polarización de entrada, 607, 626, 627  
 Corriente de prueba de zener, 129  
 Corriente de retención, 542, 548  
 Corriente oscura, 147  
 Corriente transitoria, 45  
 Corriente transitoria (sobrecorriente), 82  
 Corrientes en el transistor, 177  
 Cristal, 33-37  
 Cuadrática, 392  
 Cuarzo, 774  
 Darlington, 295  
 dB, 299, 479  
 dBm, 482  
 Década, 486  
 Decibel (dB), 299, 479  
 Derivación central, 70  
 Descarga electrostática, 355  
 Desfasamiento, 451, 453, 465, 487, 490, 502, 658, 764  
 Detección del nivel cero, 694  
 Detector de pico, 727  
 Diac, 554-555  
 Diente de sierra, 778  
 Diferenciador, 719-722  
 Difusión, 41  
 Diodo  
 de portadora caliente, 149  
 de recuperación de nivel, 152  
 emisor de luz, 144  
 láser, 152  
 foto, 146  
 PIN, 152

rectificador, 58-63  
 Schottky, 149  
 Shockley, 538-543  
 túnel, 150  
 varactor, 141-144  
 zener, 128-140  
 Diodo de recuperación de nivel, 152  
 Diodo emisor de luz, 144, 194  
 Diodo láser, 152  
 Diodo PIN, 152  
 Diodo rectificador, 58-63  
 Diodo Schottky, 149  
 Diodo Shokley, 538-543  
 Diodo túnel, 150  
 Diodo varactor, 141-144  
 Diodo zener, 128-140, 154  
 Distorsión  
 de cruce, 440  
 no lineal, 432  
 Distorsión de cruce, 440  
 Distorsión no lineal, 432  
 Dopado (adición de impurezas), 37, 208, 209, 209  
 Drenaje, 324  
 Efecto piezoelectrónico, 773  
 Eficiencia, 434, 447  
 Electroluminiscencia, 144  
 Electrón, 28  
 Electrón de conducción, 33  
 Electrón de valencia, 30  
 Electrón libre, 33  
 Emisor, 174  
 Empobrecimiento, 45, 324, 348  
 Encapsulado de transistores, 195-199  
 Enlace covalente, 31  
 Enriquecimiento, 348  
 Entrada de terminal, 598  
 Estabilidad, 232, 235, 243, 287, 346, 665, 666  
 Estéreo, 831  
 Etapa, 299  
 Factor de amortiguamiento, 814  
 Factor de rizo, 800  
 Factores de corrección, 189  
 FET, 324-365, 382-410, 508  
 FET de compuerta dual, 353  
 FET de unión (JFET), 324-347, 382, 391  
 Filtro  
 activo, 806-836  
 Bessel, 810  
 Butterworth, 810



- Órbita, 29  
 Oscilador  
     Armstrong, 713  
     Clapp, 771  
     Colpitts, 767  
         controlado por voltaje, 778, 786  
         de corrimiento de fase, 764  
         de cristal, 773  
         de puente de Wien, 759-764  
         de relajación, 780  
         doble T, 765  
         Hartley, 771  
         LC, 767  
         local, 306  
         RC, 759  
 Oscilador Clapp, 771  
 Oscilador Colpitts, 767  
 Oscilador controlado por voltaje (VCO), 778, 786  
 Oscilador de Armstrong, 773  
 Oscilador de corrimiento de fase, 764  
 Oscilador de cristal, 773  
 Oscilador de puente de Wien, 759-764  
 Oscilador de relajación, 780  
 Oscilador Hartley, 771  
 Oscilador local, 306  
 Parámetro  $r$ , 275-277  
 Parámetros  $h$ , 272-276  
 Par electrón-hueco, 33  
 Polarización  
     a través de realimentación del drenaje, 357  
     de la base, 230  
     mediante realimentación del colector, 247-249  
 Polarización de la base, 230  
 Polarización del emisor, 233-238  
 Polarización en el punto medio, 340, 422, 429, 434  
 Polarización en directa, 42  
 Polarización inversa, 45  
 Polo, 807, 811, 814, 817  
 Portadora, 833  
 Portador mayoritario, 38  
 Portador minoritario, 38  
 Potencia, 433, 438, 446, 449, 453  
 Potencial de barrera, 40, 59, 62, 65  
 Producto ganancia-ancho de banda, 507, 664  
 Protón, 28  
 Puente rectificador, 74-77  
 Punto de polarización en cd, 224-230, 231, 339, 346, 422, 423, 429, 439  
 Punto de potencia media, 508  
 Punto Q, 224-230, 231, 339, 346, 422, 423, 429, 439  
 Q (factor de calidad), 808  
 400 Jefes de operaciones  
     de observación, 20  
     de supervisión, 820  
     de transmisión, 3-43  
 Razón de espera, 561  
 Razón de rechazo en modo común (RRMC), 602, 609  
 Realimentación, 613, 614, 662, 665, 757, 761  
 Realimentación del colector, 247-249  
 Realimentación negativa, 612, 614, 662  
 Realimentación positiva, 665-671, 757, 761  
 Recombinación, 34  
 Recta de carga, 425-430  
 Rectificador, 63-77  
 Rectificador controlado de silicio (SCR), 544-548, 576  
 Rectificador de media onda, 63-69  
 Rectificador de onda completa, 69-77  
 Refracción, 574  
 Región de estrangulamiento (pinch-off), 327, 329  
 Regulación, 132-139, 850-883  
     de la tensión, 222-224, 262  
     de carga, 135, 851  
     de entrada, 132, 850  
     de línea, 132, 850  
 Regulador comutado, 861-869  
 Regulador de corriente, 877, 883-885  
 Regulador de tres terminales, 869  
 Regulador en paralelo, 858-861  
 Regulador en serie, 852-855  
 Relación de vueltas, 1  
 Resistencia de entrada, 281, 292, 295, 398, 395, 400, 402  
 Resistencia de salida, 282, 292, 298  
 Resistencia negativa, 150  
 Resistencia volumétrica, 62  
 Respuesta escalón, 520  
 RRMC, razón de rechazo en modo común, 602, 609  
 Ruptura espectral, 145, 568  
 Restaurador de cd, 91  
     auto, 337  
     cerca del punto medio, 340, 422, 430, 434  
     cero, 356  
     emisor de, 233-238  
     en directa, 42  
     inversa, 44  
         mediante divisor de voltaje, 238-247, 343, 362  
 Ruido, 600, 697  
 Ruptura  
     de avalancha, 47  
     inversa, 47  
     zener, 128  
 Ruptura de avalancha, 47  
 Ruptura inversa, 47, 548  
 Saturación, 184, 193  
 SCR, 544-548  
 SCR activado por luz (LASCR), 570-571  
 SCS, 552-554

Seguidor de fuente, 399  
 Seguidor emisor, 291  
 Semicondutor, 36-39  
 Semicondutor tipo  $n$ , 38  
 Semicondutor tipo  $p$ , 38  
 Señal grande, 425  
 Silicio, 31, 35  
 Slew rate, 610  
 Sobrecarga, 856  
 Sobretono, 774  
 Sujetador, 91, 454  
 Sumador, 711  
 Sumador con escalamiento, 711  
**T**  
 Temporizador, 781  
 Teorema de Miller, 477-479  
 Tiristor, 536-554, 565  
 Transconductancia, 334  
 Transformador, 70, 104  
 Transistor  
   de efecto de campo, 324-365, 382-410, 508  
   de paso externo, 874  
   de unijuntura, 559-565  
   de unión bipolar, 174-210, 222-256  
 Transistor de efecto de campo, 324-365, 382-410, 508  
 Transistor de unión bipolar (JFET), 559-565  
 Transistor de unión bipolar (BJT), 174-210, 222-256  
 Trazá de Bode, 493-497  
**U**  
**Y**

Trazado de señal, 304  
 Trazador de curva, 204  
 Triac, 556  
**UJT, 559-565**  
 UJT programable (PUT), 565-567, 576  
 Unión pn, 39-47  
 Unión pn, 39-47  
 Valor de cd, 65  
 Valor promedio, 65  
 VCO, 778, 780  
 Voltaje  
   cuadruplicador de, 95  
   de ruptura en la región activa directa, 540  
   divisor de, 238-247  
   duplicador de, 93  
   ganancia de, 283, 291, 296, 299, 301, 388, 389, 390, 400, 402, 431  
   multiplicador de, 93-95  
   regulación de, 850-883  
   seguidor de, 616-622  
   triplicador de, 94  
 Voltaje de compensación de entrada, 606, 628  
 Voltaje de pico inverso, 67, 72, 75  
 Voltaje de rizo, 78  
 Voltaje de ruptura en la región activa directa, 540, 548  
 VPI, 67, 73, 75  
**V**  
**W**  
**X**  
**Z**